

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年3月8日(2007.3.8)

【公開番号】特開2005-154709(P2005-154709A)

【公開日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【年通号数】公開・登録公報2005-023

【出願番号】特願2004-24878(P2004-24878)

【国際特許分類】

C 08 L	65/00	(2006.01)
C 08 K	5/18	(2006.01)
H 01 L	21/368	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	51/05	(2006.01)

【F I】

C 08 L	65/00	
C 08 K	5/18	
H 01 L	21/368	L
H 01 L	29/78	6 1 8 B
H 01 L	29/78	6 1 8 A
H 01 L	29/78	6 1 7 T
H 01 L	29/28	

【手続補正書】

【提出日】平成19年1月24日(2007.1.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

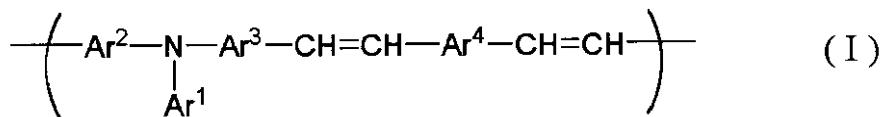
【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

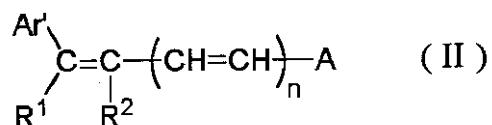
下記一般式(I)で示される繰り返し単位を有する重合体と、下記一般式(II)で示される化合物からなる混合物を含有することを特徴とする有機半導体材料。

【化1】



[式(I)中、Ar<sup>1</sup>は置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基を表し、Ar<sup>2</sup>、Ar<sup>3</sup>はそれぞれ独立に置換もしくは無置換の、単環式、非縮合多環式または縮合多環式芳香族炭化水素基の2価基を表す。Ar<sup>4</sup>はベンゼン、チオフェン、ビフェニル、アントラセンの2価基を表し、これらは置換基を有していてもよい。]

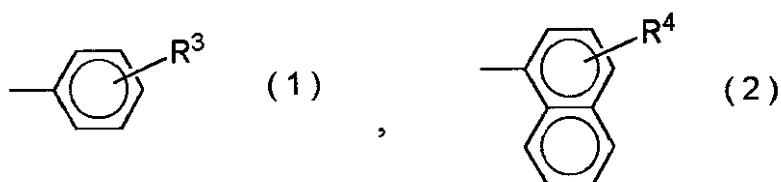
【化2】



[式(II)中、nは0または1の整数、Ar'は置換もしくは無置換のアリール基を表し、R<sup>1</sup>は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基あるいは置換もしくは無置換のアリール基を表し、R<sup>2</sup>は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基あるいは置換もしくは無置換のアリール基を表し、Ar'とR<sup>1</sup>は共同で環を形成してもよい。]

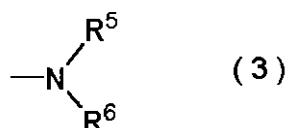
Aは下記一般式(1)、(2)で示される基、9-アントリル基または置換もしくは無置換のカルバゾリル基を表す。

【化3】



式(1)(2)中、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は水素原子、アルキル基、アルコキシル基、ハロゲン原子、又は下記一般式(3)で示される基を表す。

【化4】



式(3)中、R<sup>5</sup>およびR<sup>6</sup>は置換もしくは無置換のアルキル基、置換または無置換のアリール基を表し、R<sup>5</sup>およびR<sup>6</sup>は同一でも異なっていてもよく、R<sup>5</sup>およびR<sup>6</sup>は互いに結合して環を形成してもよい。]

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項14

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項14】

請求項1~10のいずれかに記載の一般式(I)、(III)、(IV)、(V)、(

(V I )、(V I I )、(V I I I )、(I X )、(X )、又は(X I )で示される繰り返し単位を有する重合体と、請求項1に記載の一般式(I I )で示される化合物からなる混合物を含有する有機半導体材料の溶液を塗布した後、溶媒を乾燥させて有機半導体層を形成する工程を含むことを特徴とする有機薄膜トランジスタの製造方法。